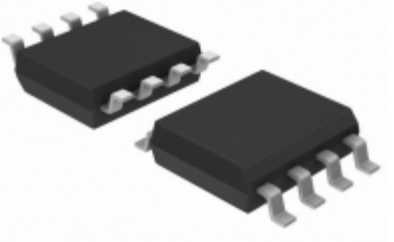

	<p><b>SI4214DY-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI4214DY-T1-GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 30V 8.5A 8-SOIC</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4214DY-T1-GE3.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 22189 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4214DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 8.5A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	22189 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 8.5A 3.1W
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	3.1W
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.5A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	23.5 mOhm @ 7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	785pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI4214DY-T1-GE3-ND

SI4214DY-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI4214DY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4214DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4214DY-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI4214DY</b> SI SI4214DY SI</p>	 <p><b>SI4214DY-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 8.5A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4220-GMR</b> SILICON SI4220-GMR SILICON</p>	 <p><b>SI4226DY-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 25V 8A 8SOIC</p>
 <p><b>SI4221-GM</b> SILICON SI4221-GM SILICON</p>	 <p><b>SI4214DY-T1-E3</b> VISHAY SI4214DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI4220-GM</b> SILICON SI4220-GM SILICON</p>	 <p><b>SI4226DY</b> SI SI4226DY SI</p>

heiße Teile

Mehr

SI4200DB-BMR	SI4200DY-T1-E3	SI4201-BMR	SI4201-GMR	SI4202DY
SI4205-BM	SI4205-BMR	SI4206-BM	SI4206-BMR	SI4208-A-GMR
SI4208GM	SI4209-A-GMR	SI4210-C-GMR	SI4210-D-GMR	SI4210-GM
SI4210DY-T1-E3	SI4210DY-T1-GE3	SI4210DY-T1-GE3	SI4210GM	SI4214DDY
SI4214DDY-T1-E3	SI4214DDY-T1-E3	SI4214DDY-T1-GE3	SI4214DDY-T1-GE3	SI4214DY-T1-E3
SI4214DY-T1-GE3	SI4220-GM	SI4226DY	SI4226DY-T1-E3	SI4226DY-T1-E3
SI4226DY-T1-GE3	SI4226DY-T1-GE3	SI4228DY	SI4228DY-T1-E3	SI4228DY-T1-E3
SI4228DY-T1-GE3	SI4228DY-T1-GE3	SI4232DY	SI4276DY-T1-E3	SI4276DY-T1-E3
SI4282DVP	SI4286DY	SI4286DY-T1-GE3	SI4286DY-T1-GE3	SI4288DY
SI4288DY-T1-GE3	SI4288DY-T1-GE3	SI4300-BM	SI4300-E-BM	SI4300DY-T1-E3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited